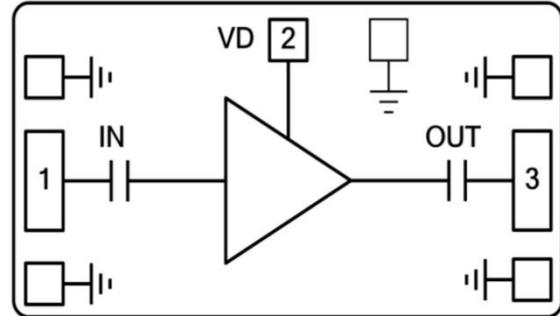




主要特点

- 工作频率: 0.5 - 4 GHz
- 噪声系数: 0.9 dB
- 增益: 22.5 dB
- 输出 P1dB: +20 dBm
- 自偏置供电: 48 mA@+5 V
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.5× 1.0× 0.1 mm³

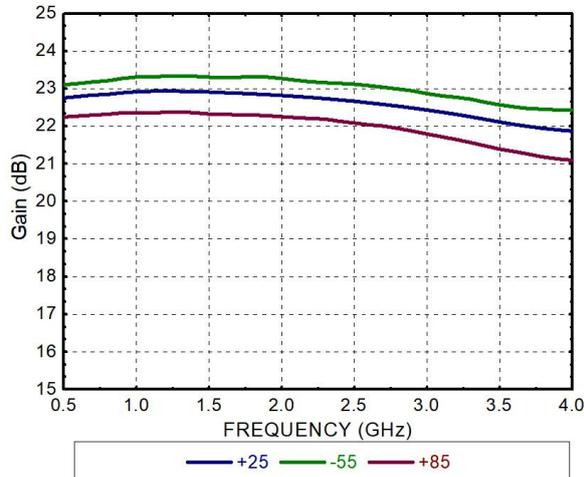
功能框图



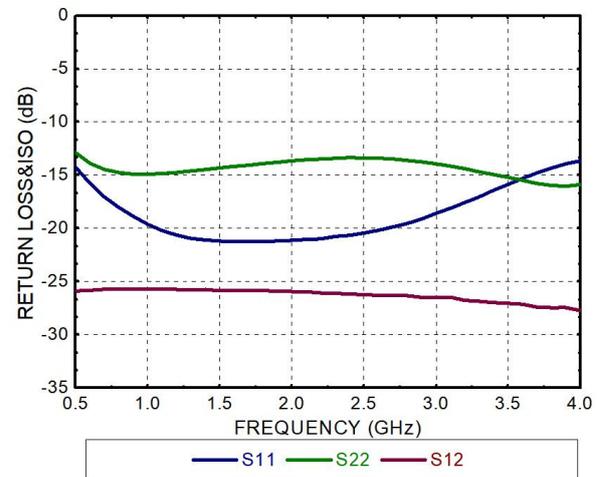
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VD = +5\text{ V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	0.5 - 4			GHz
增益		22.5		dB
增益平坦度		±0.6		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		15		dB
输出功率 1dB 压缩点		20		dBm
饱和输出功率		21		dBm
输出 IP3		31		dBm
噪声系数		0.9		dB
工作电流	30	48	70	mA

增益



回波损耗&反向隔离





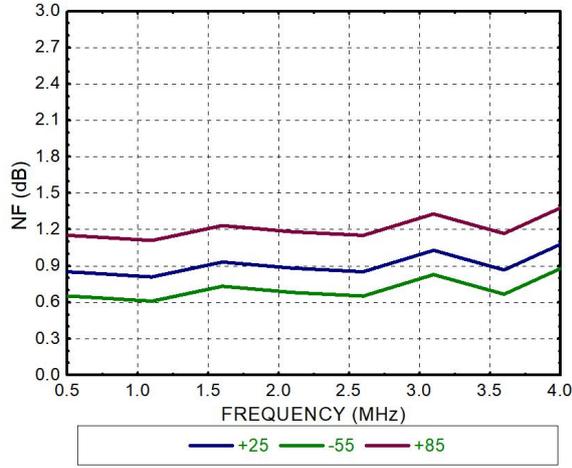
中科海高
HiGaAs Microwave

V1.1

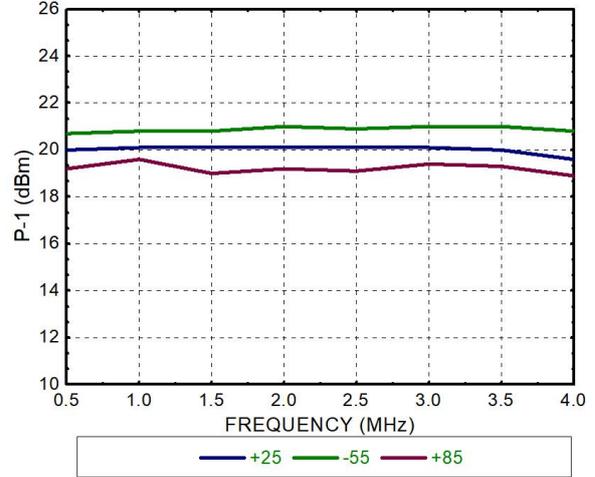
HGC301-10A

GaAs pHEMT MMIC
低噪声放大器 0.5 - 4 GHz

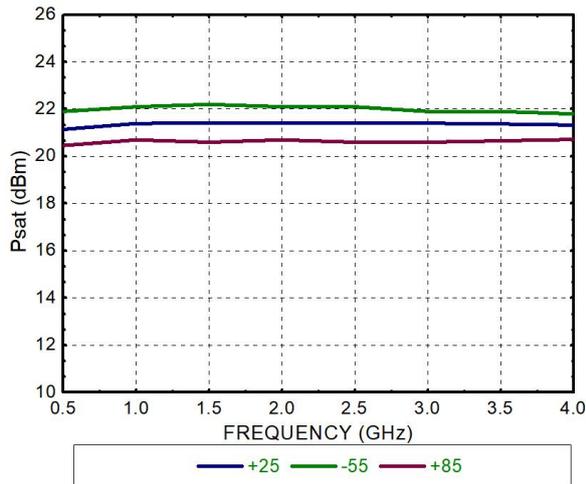
噪声系数



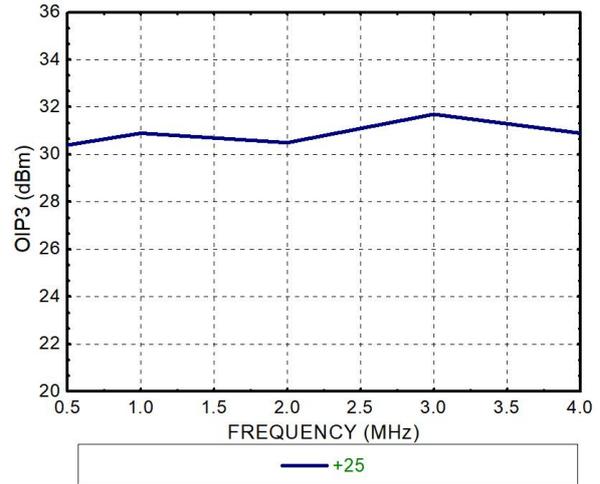
输出P₋₁



输出功率P_{sat}



OIP3



物理参数

